SOT23 N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET

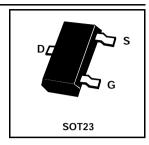
BS170F

ISSUE 3 - JANUARY 1996

FFATURES

- * 60Volt V_{DS}
- * $R_{DS(ON)} = 5\Omega$

PARTMARKING DETAIL - MV



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Drain-Source Voltage	V _{DS}	60	V
Continuous Drain Current at T _{amb} =25°C	I _D	0.15	mA
Pulsed Drain Current	I _{DM}	3	Α
Gate Source Voltage	V_{GS}	± 20	V
Power Dissipation at T _{amb} =25°C	P _{tot}	330	mW
Operating and Storage Temperature Range	T _j :T _{stg}	-55 to +150	°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at T_{amb} = 25°C unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.	
Drain-Source Breakdown Voltage	BV _{DSS}	60	90		V	I _D =100μA, V _{GS} =0V	
Gate-Source Threshold Voltage	V _{GS(th)}	0.8		3	V	$I_D=1mA$, $V_{DS}=V_{GS}$	
Gate-Body Leakage	I _{GSS}			10	nA	V _{GS} =15V, V _{DS} =0V	
Zero Gate Voltage Drain Current	I _{DSS}			0.5	μΑ	V _{DS} =25V, V _{GS} =0V	
Static Drain-Source On-State Resistance (1)	R _{DS(on)}			5	Ω	V _{GS} =10V, I _D =200mA	
Forward Transconductance (1)(2)	g _{fs}		200		mS	V _{DS} =10V, I _D =200mA	
Input Capacitance (2)	C _{iss}		60		pF	V _{DS} =10V, V _{GS} =0V, f=1MHz	
Turn-On Delay Time (2)(3)	t _{d(on)}			10	ns	V _{DD} ≈-15V, I _D =600mA	
Turn-Off Delay Time (2)(3)	t _{d(off)}			10	ns		

⁽¹⁾ Measured under pulsed conditions. Width=300µs. Duty cycle ≤2% (2) Sample test.

For typical characteristics graphs refer to ZVN3306F datasheet.

⁽³⁾ Switching times measured with 50Ω source impedance and <5ns rise time on a pulse generator Spice parameter data is available upon request for this device



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина,

дом 2, корпус 4, литера А.